## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

07-232960

(43)Date of publication of application: 05.09.1995

(51)Int.CI.

CO1G 1/00 CO1G 29/00 H01B 13/00

(21)Application number: 06-022255

(71)Applicant: KYOCERA CORP

(22)Date of filing:

21.02.1994

(72)Inventor: FUJIOKA HIROMI

INOUE TAKAYUKI

## (54) PRODUCTION OF OXIDE SUPERCONDUCTOR

## (57)Abstract:

PURPOSE: To attain high density as well as to increase the degree of grain orientation in a sintered compact and to stably obtain an oxide superconductor having high critical current density.

CONSTITUTION: A mixture of oxides of elements constituting an oxide superconductor or compds. capable of forming the oxides is compacted or calcined and compacted to form a compact. This compact is fired in an oxidizing atmosphere and the resulting sintered compact is repeatedly subjected to the application of ≥50kg/cm2 pressure and release from the pressure under heating at 800-860° C.

### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

## (11)特許出願公開番号

## 特開平7-232960

(43)公開日 平成7年(1995)9月5日

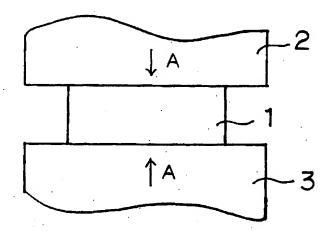
(51) Int.Cl. 6		識別記号	庁内整理番	号	FI			ŧ	技術表示箇所
C 0 4 B	35/45	ZAA							
C01G	1/00	S							
	<b>29/0</b> 0	ZAA							
H01B		565 A				•			
	,				C04B	35/ 00	ZAA	K	
•					審查請求	未請求	請求項の数1	OL	(全 5 頁)
(21) 出願番	 身	特顧平6-22255			(71) 出顧人	000006	633		
(01) [211]				İ		京セラ	株式会社		
(22) 出顧日		平成6年(1994)2月21日				京都府	京都市山科区東!	<b>野北井</b> 。	ノ上町5番地
(EE) HIRN H		TMO T (1001) 2	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			の22			
					(72)発明者	藤岡	ひろみ		•
							県国分市山下町	1番45	身 京セラ株
							総合研究所内	•	
					(72)発明者				
				l	(,)		県国分市山下町	1番4	身 京セラ株
				Ì			総合研究所内	-	
				.		MARTI			•
				1					
				1					
				ļ			<u> </u>		

## (54) 【発明の名称】 酸化物超電導体の製造方法

## (57)【要約】

【構成】酸化物超電導体を構成する元素の酸化物あるいは酸化物形成可能な化合物からなる混合物を成形するか、あるいは該混合物を仮焼後成形する工程と、該成形体を酸化性雰囲気中で焼成する工程と、該焼結体を800~860℃の加熱状態で50kg/cm²以上の圧力を付与及び圧力解除を繰り返す工程とを具備する。

【効果】焼結体で結晶粒子の配向度を高めるとともに高 密度化が達成でき、臨界電流密度が高い酸化物超電導体 を安定して得ることができる。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】酸化物超電導体を構成する元素の酸化物あるいは酸化物形成可能な化合物からなる混合物を成形するか、あるいは該混合物を仮焼後成形する工程と、該成形体を酸化性雰囲気中で焼成する工程と、該焼結体を800~860℃の加熱状態で50kg/cm²以上の圧力を付与及び圧力解除を繰り返す工程とを具備する酸化物超電導体の製造方法。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【産業上の利用分野】本発明は、酸化物超電導体の製造 方法に関し、詳細には、高密度で且つ高配向の酸化物超 電導体の組織的な均質性を向上させるための製造方法に 関する。

#### [0002]

【従来技術】近年、超電導体として従来から用いられてきた金属系超電導体よりも高い臨界温度Tc(抵抗がゼロになる温度)を有する材料として酸化物超電導体が発見され、その実用化が期待されている。

【0003】現在、酸化物超電導体としては、主として Y-Ba-Cu-O系(以下、Y系という)およびBi-Sr-Ca-Cu-O系(以下、Bi系という)およびT1-Ba-Ca-Cu-O系(以下、T1系という)の3種が主として知られている。これらの酸化物超電導体は、その実用化に際しては高い臨界温度を有するとともに臨界電流密度(抵抗ゼロにおける電流値)が大きいことが必要とされている。このような特性を得ためにはその相対密度を高めると共に高配向化することが最も重要であると言われている。

【0004】そこで、従来より高密度の酸化物超電導体を作製する方法として、従来より高い機械的な圧力を加えつつ加熱するホットプレス法が採用されている。

#### [0005]

【発明が解決しようとする問題点】しかしながら、ホットプレス法については結晶粒子の配向性が不十分であるために得られる焼結体の臨界電流密度もせいぜい3000A/cm²以下であり、実用的レベルには到底達していないのが現状であった。

【0006】そこで、本発明者等は先に低T c 相の仮焼粉末を常圧で焼成して充分に高T c 相を生成した後、該焼結体に圧力を加えつつ加熱処理を行う、いわゆるホットフォージング処理を行うことによって、高配向、高密度でJ c 値が 4 5 0 0 A/c m² 程度の優れた酸化物超電導体が得られることを提案した。しかしながら、かかる方法によれば、加圧時に超電導体中にクラックが生じるために得られた構造体が不均一な組織になりかつ超電導特性も部分的に不均質になるという問題があった。

#### [0007]

【問題点を解決するための手段】本発明者等は、上記問 結体 1 を適当な加熱手段(図示せず)によって加熱しな 題点に対して検討を重ねた結果、先に提案した方法をさ 50 がらプレスパンチ 2, 3 によって A 方向に圧力を付与し

らに改良し、前記の構成においてホットフォージング処理を行うに際し、800~860℃で加熱した状態で50kg/cm²以上の圧力を付与及び圧力解除を繰り返すことにより、加圧により酸化物超電導体中に生じたクラックを焼結により消失させることができ均質な組織を有し、かつ均質な高い超電導特性が得られることを知見した。

【0008】即ち、本発明の酸化物超電導体の製造方法は、酸化物超電導体を構成する元素の酸化物あるいは酸化物形成化合物からなる混合体を成形するか、あるいは酸混合体を仮焼した後に成形し、該成形体を一旦酸化性雰囲気中で焼成した後に、800~860℃の加熱状態で50kg/cm²以上の加圧及び圧力解除を繰り返すことを特徴とするものである。

【0009】以下、本発明を詳述する。本発明の製造方法によれば、まず酸化物超電導体を構成する金属の酸化物粉末あるいは焼成により酸化物を形成しうる炭酸塩や硝酸塩粉末を用い、酸化物超電導体を形成する割合に秤量混合する。

【0010】具体的には前述したBi 系酸化物超電導体のうち高Tc 相を作成する場合には、Bi2O3、SrO、CaCO3、CuOO各粉末を用いてこれらを原子比においてSr を 2 としたとき、Bi が 1 .  $8\sim 2$  . 2 、Ca が 2 .  $0\sim 3$  . 5 、Cu が 3 .  $0\sim 4$  . 5 の範囲になるように秤量する。また、高Tc 相の生成量を増加させることを目的として上記の混合体にさらにPbO 粉末、およびK2CO3、Na2CO3、Li2CO2 等をSr を 2 としてPb を 0 .  $1\sim 0$  . 5 、K 、Li 、Na を 0 .  $05\sim 0$  . 6 の割合で混合することができる。得られた混合物は所望により7  $00\sim 8$  5 0  $\infty$  の 化性雰囲気中で $1\sim 2$  0 時間程度仮焼した後に成形する

【0011】成形は公知の成形手段によって行うことができ、例えばプレス成形、押出し成形、ドクタープレード成形法等により実施される。

【0012】次に、上記のようにして得られた成形体を840~855℃の酸化性雰囲気中で焼成する。この焼成によって一旦低Tc相の燐片状の結晶が生成されるとともに焼成が進行するに従い、低Tc相から高Tc相に変換される。

【0013】この焼成を非加圧で行うと燐片状の結晶の成長により低密度の焼結体となるため、ホットプレス焼成で行ってもよい。上記焼成工程終了時点では、焼結体の燐片状結晶はほとんど無配向状態である。

【0014】次に、上記の酸化物超電導焼結体をホットフォージング処理する。この処理方法を図1を用いて説明する。図中、1は酸化物超電導体焼結体、2,3はプレスパンチである。本発明によれば、酸化物超電導体焼結体1を適当な加熱手段(図示せず)によって加熱しながらプレスパンチ2.3によってA方向に圧力を付与し

た後、圧力を解除し、再度圧力を付与しこれを複数回繰 り返す。この時の圧力は50kg/cm²以上、1回の 加圧時間は1~3600秒、加熱温度は800~860 ℃が適当である。また圧力解除状態での加熱時間は1~

3600秒が適当である。尚、繰り返し回数は1~50 0回程度がよい。

【0015】本発明において加熱温度を800~860 ℃に限定したのは800℃より低いと、焼結が進まず超 電導体が破断された状態になる為であり、860℃を越 えると、溶融が起こり超電導相が分解するためである。 尚、820~850℃が好適である。

【0016】また、圧力は50kg/cm² より低い と、得られる超電導体の密度及び配向度が低く、超電導 特性も低くなる。尚、100~1000kg/cm² が 好適である。

【0017】更に、一回の加圧時間を3600秒以内に 限定したのは、3600秒より長く加圧するとクラック が大きくなり焼結によってクラックを消失させることが 困難となる場合があるためである。また、加圧時に比べ 圧力解除時の温度は1~20℃程度高くすることも出来 20

【0018】このホットフォージング処理により、酸化 物超電導体焼結体は均一な高密度と配向度を有する組織 体となる。

【0019】また、このホットフォージング処理によれ ば、図1において、酸化物超電導体1とプレスパンチ 2, 3との間にAl2 O3 、ZrO2 などの酸化物系セ ラミック粉末またはそれらの焼結体Ag、Au、Cu、 Pt等の延性のある 金属からなる厚さ0.05mm以 上の金属板を介在して処理を行うことも強度や配向度を 30 髙める上で望ましい。

### [0020]

【作用】本発明の構成によれば、焼成によって得た酸化 物超電導焼結体をホットフォージング処理中に加圧及び 圧力解除を繰り返すことが最も重要である。このような 処理を施すと、加圧時に酸化物超電導体中に生じたクラ ックが圧力解除時に焼結により消失することによって加 圧時のクラックが解消されるためホットフォージング処 理により得られる酸化物超電導焼結体の組織的な均質性 を飛躍的に向上させることができる。

【0021】また、超電導焼結体とプレスパンチの間に 延性金属を介在させると、延性金属自身が加圧方向と直\* f = (P - Po) / (1 - Po)

\*角な方向に圧延され、それと同時に焼結体も同様な方向 に圧延されるために焼結体中の燐片状結晶粒子が配向さ れるとともに圧縮され焼結体の密度を高くすることがで きる。この時、加圧により生じた金属中の転位が圧力解 除時に消失するために再度加圧する時に加圧状態で保持 した場合よりも容易に圧延される。それにより、燐片状 結晶同士の密着性が飛躍的に向上するため に酸化物超 電導体の臨界電流密度をさらに高くすることができる。

【0022】また、ホットフォージング処理時に、加圧 時の温度に比べ圧力解除時の温度を高くすると加圧によ 10 り110K相の生成温度領域が低くなり、高温超電導焼 結体を得ることができる。

[0023]

#### 【実施例】

#### 実施例1

原料粉末としてBi2 O3 、PbO、SrCO3 、Ca CO3 、CuOの各粉末を各金属のモル比がBi:P b: Sr: Ca: Cu = 1.93: 0.36: 2:3.17:4.25となるように秤量後、750~810℃ で20時間仮焼し、粉砕して平均粒径5 μm の低T c 相 を多量に含む仮焼粉末を得た。この仮焼粉末をφ60m mの金型を用いて成形圧0.5ton/cm2 で成形し て厚み約2mmの円板状成形体を得た。

【0024】次に、上記成形体を大気中で840℃の温 度で150時間焼成したところ、比重2.0(アルキメ デス法に基づく)の焼結体が得られた。また、組織観察 したところ、高Tc相の燐片状の結晶がランダムに配列 していた。

【0025】次に、酸化物超電導体焼結体を図1に従 い、焼結体の上下面にアルミナ質焼結体製の厚み0.5 mmのプレートを配置し、このプレートを介して焼結体 に対して830℃の温度で5ton/cm² の圧力で加 圧時間 5 分、圧力解除時間 5 分を 1 回として、繰り返し 回数120回でホットフォージング処理した。このよう にして得られた焼結体を試料No.1とした。

【0026】最終的に得られた焼結体に対してアルキメ デス法により比重を調べるとともにX線回折測定を行 い、X線回折のチャートデータに基づき、下記数1から (001) 面の配向度 f を求めた。

[0027] 40

【数1】

式中、P (配向試料) = ΣI(00ℓ) / (ΣI(hkℓ) + ΣI(00ℓ))  $P_0$  (未配向材料) =  $\Sigma$  1'(00½) / ( $\Sigma$  1'(bkℓ) +  $\Sigma$  1'(00ℓ) ]

【0.028】さらに、上記焼結体について、抵抗法に基 づき、試料を液体窒素中で電流を徐々に高め、高圧端子 に1μV/cmの電圧が生じた時の電流値を臨界電流密 度m Jcとして求め、同時に臨界温度m Tcも測定した。結 m 50 から磁場を印加し反対側の面で検出される磁場(磁気シ

果は表1に示した。

【0029】また、試料の超電導特性の均質性を調べる ために、上記焼結体について、試料を液体窒素中で片面 10

3

ールド特性)を測定し、検出される磁場が5ガウスを越える印加磁場値(Bsh)を測定するとともに試料面でのシールド特性の分布を測定し、その結果を図2に示した。

#### 【0030】実施例2

実施例1において、ホットフォージング処理を、酸化物 超電導体と酸化物セラミックス焼結体との間に銀製の厚み0.  $1 \, \mathrm{mm}$ のプレートを配置する以外は、実施例1と全く同様にして焼結体試料N0.2を作製し、同様に特性の評価を行った。結果は表1、図3に示した。

## 【0031】比較例1

実施例2において、ホットフォージング処理の加圧条件を5 ton/cm $^2$ の圧力で10時間とする以外は、実施例1と全く同様にして焼結体試料No,3を作製し、同様に特性の評価を行った。結果は表1、図4に示した。

#### 【0032】実施例3

実施例1において、ホットフォージング処理時に、酸化物超電導体と酸化物セミックス焼結体との間に銀製の厚み0.1mmのプレートを配置し、ホットフォージング処理の加圧条件を830℃の温度で5ton/cm²の20圧力で加圧時間5分、840℃の温度で圧力解除時間5分を1回とし、繰り返し回数120回でホットフォージング処理とする以外は、実施例1と全く同様にして焼結体(試料No,4)を作製し、同様に特性の評価を行った。結果は表1、図5に示した。

#### [0033]

#### 【表1】

1.1				
試料 Na	f %	Тс (K)	J c A/cm²	B G .
· 1	7 5	105	12000	100
2	9 0	106	21000	150
* 3	7 0	103	8000	5 0
4	9 5	107	33000	200

\*印は本発明の範囲外の試料を示す。

【0034】表1及び図2~5から明らかなように、加圧及び圧力解除を繰り返した実施例1は、加圧状態のみで保持した比較例1に比べ、磁気シールド特性にばらつきがなく、超電導特性が試料内で均一であることがわかる。また、ホットフォージング処理に際して延性金属を焼結体と酸化物系セラミックスの間に介在させた実施例2は配向度、Jc値、Tc値のいずれにおいても、実施例1よりもさらに優れた酸化物超電導体を得ることができた。さらに、圧力解除時の温度を10℃高くした実施例3は配向度、Jc値、Tc値のいずれにおいても、実

#### [0035]

【発明の効果】以上、詳述した通り、本発明の方法によれば、焼結体の結晶粒子の配向度を高めるとともに高密度化が達成できるために高臨界温度を有し且つ臨界電流密度が極めて高い酸化物超電導体を安定して得るとともに均質な組織および超伝導特性を有する構造体を得ることができる。

施例2よりもさらに優れたものであった。

【0036】このように、試料全体が均一に臨界電流密度の高い酸化物超電導体が得られることにより優れた磁気シールド特性を示し、磁気シールド体をはじめとする各種の酸化物超電導体の実用化を進めることができる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の酸化物超電導体の製造方法におけるホットフォージング処理を説明するための図である。

【図2】本発明の実施例1の酸化物超電導体の磁気シールド特性の分布状態を表すための図である。

【図3】本発明の実施例2の酸化物超電導体の磁気シールド特性の分布状態を表すための図である。

30 【図4】比較例1の酸化物超電導体の磁気シールド特性 の分布状態を表すための図である。

【図 5】 本発明の実施例3の酸化物超電導体の磁気シールド特性の分布状態を表すための図である。

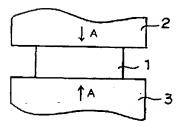
#### 【符号の説明】

1・・・酸化物超電導焼結体

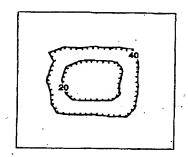
2. 3・プレスパンチ

40

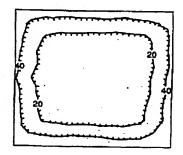




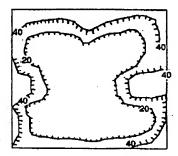
【図2】



[図3]



【図4】



【図5】

